

平成 22 年度 電磁気学 II (高瀬) 期末試験

2010.7.26

1. 半径 a の無限に長い誘電体 (誘電率 ϵ) の円筒の軸を z 軸とする。これに x 方向に一様な電場 $E_0\vec{x}$ をかけたとき, 円筒の内外におけるポテンシャル分布を求めよ。
2. 磁性体を磁場 \vec{H} の中に置いたときに生じる磁化を $\vec{M} = \chi_m\vec{H}$ と表せるとき, χ_m を磁化率と呼ぶ。無限に広がった, 磁化率 χ_m で厚み a の磁性体に, 外部磁場 \vec{H} を厚み方向に加えると, どれだけ磁化するか。この場合の磁性体内外の磁場 \vec{H} および磁束密度 \vec{B} の分布を求めよ。
3. 真空中を z 方向に伝搬してきた, 複素振幅 \hat{E}_{i0} の電場をもつ, 周波数 ω の電磁波が, $z \geq 0$ の領域を占める金属の表面に垂直に入射してきた。但し σ および ϵ を金属の電気伝導率および誘電率とし, $\omega \ll \sigma/\epsilon$ の場合を考える。真空の誘電率は ϵ_0 とし, 入射電磁波の電場は x 方向に偏向しているとする。
 - (a) $z > 0$ における電場 $\vec{E}_m(z, t)$ はどう表されるか。
 - (b) 金属表面から反射した電磁波の複素振幅を \hat{E}_{r0} とする。金属表面での接続条件より, 電力反射率 $|\hat{E}_{r0}|^2/|\hat{E}_{i0}|^2$ を求めよ。
4. 束縛電子を調和振動子でモデルすると, 誘電率は以下のように表される。

$$\frac{\epsilon}{\epsilon_0} = 1 + \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m} \sum_j \frac{f_j}{\omega_j^2 - \omega^2 - i\omega\gamma_j}, \quad \sum_j f_j = Z$$

但し N は分子の密度, f_j は 1 分子中で共鳴周波数 ω_j , 減衰率 γ_j をもつ電子の数を表し, Z は 1 分子あたりの全電子数である。振動子の減衰が弱く, $\gamma_j \ll \omega_j$ の場合, 共鳴周波数 ω_j における (電力) 吸収係数, およびこの吸収スペクトル線の (電力) 半値全幅を求めよ。但し複素波数を $k = (\omega/c)\sqrt{\epsilon/\epsilon_0} = \beta + i\alpha/2$ としたとき, α を吸収係数と呼び, $|\alpha/\beta| \ll 1$ としてよい。